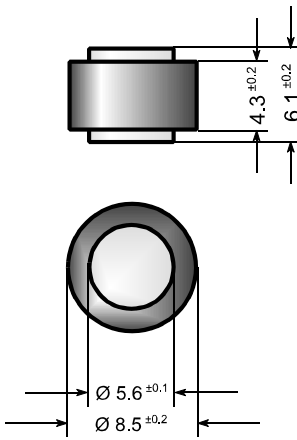


Silicon Rectifier Button-Cells

Si-Gleichrichterzellen in Button-Bauform



Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom	25 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...1000 V
Plastic case, coloured ring indicates cathode Kunststoffgehäuse, Kathode am Farbring	Ø 10 x 6.2 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	1.9 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	

Standard packaging: bulk – Standard Lieferform: Schüttgut

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
RA 2505	50	60
RA 251	100	120
RA 252	200	240
RA 254	400	450
RA 256	600	650
RA 258	800	850
RA 2510	1000	1050

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_T = 100/C$	I_{FAV}	25 A ¹⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15$ Hz	I_{FRM}	60 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50 / 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25/C$	I_{FSM}	500 / 550 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25/C$	i^2t	1250 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	- 50...+175/C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	- 50...+175/C

¹⁾ Max. temperature of the terminals $T_T = 100/C$ – Max. Temperatur der Kontaktflächen $T_T = 100/C$

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25/C$	$I_F = 25\text{ A}$	V_F	< 0.95 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25/C$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 : A
	$T_j = 125/C$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 100 : A
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Kontaktfläche			R_{thT}	< 1 K/W

